

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

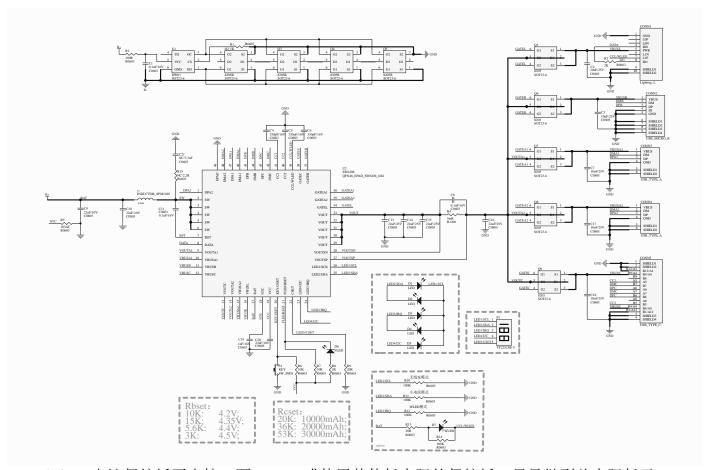
# SW6208 原理图设计指南

### 1. 版本历史

- V1.0 初始版本;
- V1.1 增加定制数码管设计电路、L口的 ID1 Pin 加上拉电阻、MCU 方案电路修改等;
- V1.2 增加 L 口的 ID0 与 ID1pin 之间串联短接电阻、WLED 需并联  $100k \Omega$  电阻等;
- V1.3 SW 增加 RC 电路、MCU 方案快充指示灯由 MCU 驱动点亮等;
- V1.4 VBUSB 对地加并联  $1k\Omega$  电阻、L口的 ID0 与 ID1pin 之间串联短接电阻修改、单 A口方案电路修改;
- V1.5 单 C 口方案电路修改;
- V1.6 输出电容电路和描述、VBUSB 电路和描述修改;
- V1.7 单 C 口方案 Type-A1 口通路电路修改;
- V1.8 更新文档图标;

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

#### 2. SW6208 原理图参考设计



- (1)、电池保护板至少接 4 颗 8205,或使用其他低内阻的保护板,尽量做到总内阻低于  $10m\Omega$ ;
- (2)、电池端需要接 2 颗或以上 22uF/10V 的陶瓷电容;
- (3)、电感采用 2.2uH 感值,要求饱和电流 10A 以上,DCR 小于  $8m\Omega$ ;
- (4) 、 VOUT 端采样电阻前要求 3 颗封装 0805 以上、容值 22uF/25V 的陶瓷电容,如果要求输出电压纹波足够小,可以根据需求增加滤波电容的数量;采样电阻后需加一颗封装 0805、容值 22uF/25V 的陶瓷电容;
  - (5)、VOUT 端采样电阻采用  $5m\Omega$ 合金电阻, 封装 1206,精度 1%以内, 温度系数小于 100PPM;
- (6)、VOUT 端采样电阻并联封装 0603 的 0.1uF/16V 电容,该电容 Layout 时靠近电流采样电阻摆放,不能放置其他地方:
  - (7)、通路管使用 NMOS,可采用 8205 里的两颗 NMOS 并联使用,减小通路内阻;
- (8)、Type-A1/Type-A2/Type-C 口的轻载检测采用检测通路管 NMOS 压降来实现,轻载电流为  $60\text{mA}@10\text{m}\Omega$ ,选用不同通路管时需考虑对轻载检测电流门限的影响;
- (9)、VOUTA1/VBUSA1、VOUTA2/VBUSA2、VOUTC/VBUSC 为 Type-A1、Type-A2、Type-C 口的轻载检测采样点,需直接从 Type-A1、Type-A2、Type-C 口的通路管的 D/S 端连接,不能有任何共用电流路径;
- (10)、通路管驱动采用 Chargepump,驱动能力很弱,需要选用 GS 漏电(IGSS) 100nA 的 NMOS 管:
  - (11)、通路管到各接口母座需接 10uF 或 22uF 耐压 16V 以上的滤波电容,尤其是 Type-A1、Type-A2



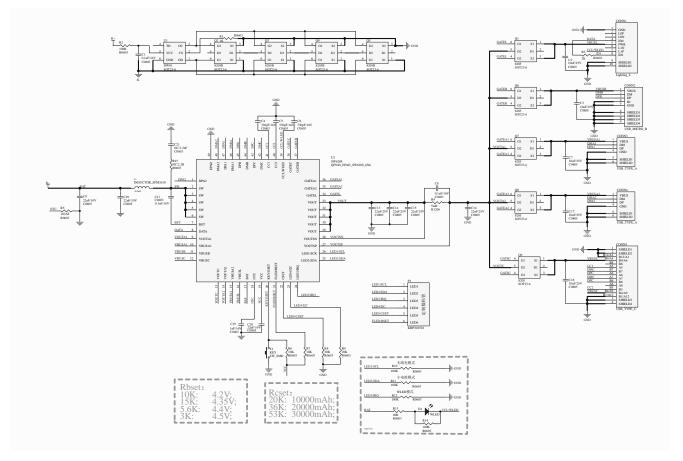
ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

母座,不接会影响负载接入检测功能:

- (12)、DPA1/DMA1/DPA2/DMA2/DPB/DMB/DPC/DMC 信号引脚到各接口母座端口可串联 22 Ω 电阻提高端口耐压能力;
- (13)、NTC 引脚接 NTC 电阻 103AT 且需对地接 1nF/16V 滤波电容,可通过串并联电阻的方式调整保护温度,通过并联大电阻可将低温值调低,通过串联小电阻可将高温值调高;如果不使用 NTC 功能,NTC 引脚直接接  $10K\Omega$  电阻到地或直接接地;
- (14)、VCC 为内外部供电电源,滤波电容 22uF/10V,关机时输出电压为电池电压,开机时输出 5V,负载能力60mA;如需给外部器件供电尽量不要超过20mA,避免芯片效率降低及发热;
- (15)、KEY/GSET 引脚为复用引脚,可通过修改该引脚上拉到 VCC 的电阻阻值来配置恒流充电时间的比例;
- (16)、FLED/BSET 引脚为复用引脚,可通过修改该引脚上拉到 VCC 的电阻阻值来设置充电目标电压:快充指示灯的限流电阻取值采用  $2K\Omega$ ,过小会影响 Boost 效率及发热:
  - (17)、支持 3~5 颗 LED 灯,按照 D1~D5 的顺序连接;
  - (18)、支持 188 数码管,型号 YF2252SB-5,按照 LED1/SCK~LED5/CSET 的顺序连接;
  - (19)、LED5/CSET 引脚可复用成电池容量配置功能,通过对地挂不同电阻设置不同的电池容量;
  - (20)、CC1、CC2、CCL/WLED 需要对地接 330pF/16V 陶瓷电容;
- (21)、LED1/SCK 对地接 100K 电阻时,设置为无线充模式;在无线充模式下,Type-A2 口接无线充模块,此时 Type-A2 口的负载接入检测功能将禁止,轻载检测电流及轻载检测时间也会根据无线充模块进行优化;
- (22)、LED2/SDA 对地接 100K 电阻时,设置为小电流模式,通过长按进入或退出小电流模式;在小电流模式下,2小时内禁止轻载检测功能,从而可对蓝牙耳机、手环等小电流设备充电;
- (23)、LED3/IRQ 对地接 100K 电阻时,CCL/WLED 引脚设置为照明驱动功能,此时 WLED 需并联 100k 电阻,L 口无快充功能;
- (24)、L 口支持解密功能,支持内部解密及外部解密;当使用内部解密时,DATA Pin 直接接 L 口的 ID0 Pin, L 口的 ID1 Pin 与 ID0 Pin 之间串联 2K 电阻;当使用外部解密时,DATA Pin 直接接到 VCC,使用外部解密芯片对 L 口进行解密。
- (25)、SW Pin 可以对地加 RC 电路改善 EMI, 其中电阻选择封装为 0603 的 2.2R 电阻, 电容选择 封装为 0603 的 3.3nF 电容:

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

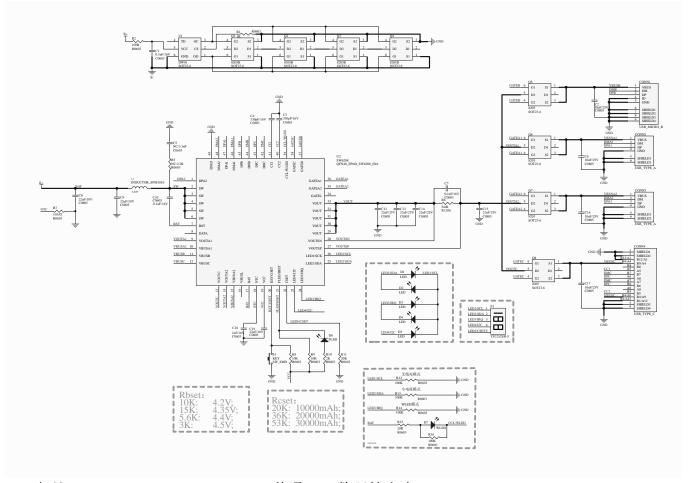
#### 2.2 SW6208+A+A+B+C+L+快充 188 数码管



- (1)、选用型号为 KHP302518 快充 188 数码管;
- (2)、LED4/I2C 对地接 100K 电阻,设置为定制数码管模式;
- (3)、去掉快充指示灯 D6 及其 2K 的限流电阻 R8;
- (4) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

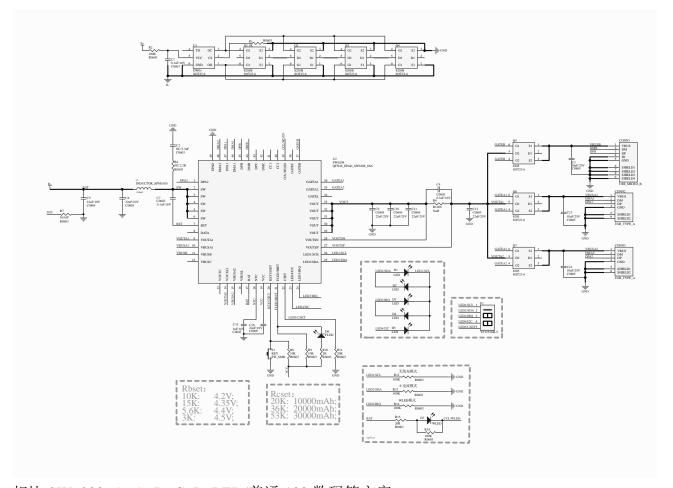
#### 2.3 SW6208+A+A+B+C+LED/普通 188 数码管



- (1)、VBUSL/GATEL/DATA 和 CCL/WLED 悬空,去掉 L 口的通路管、L 口的 ID1 Pin 与 ID0 Pin 之间串联的电阻、L 口母座及输入滤波电容;
  - (2) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

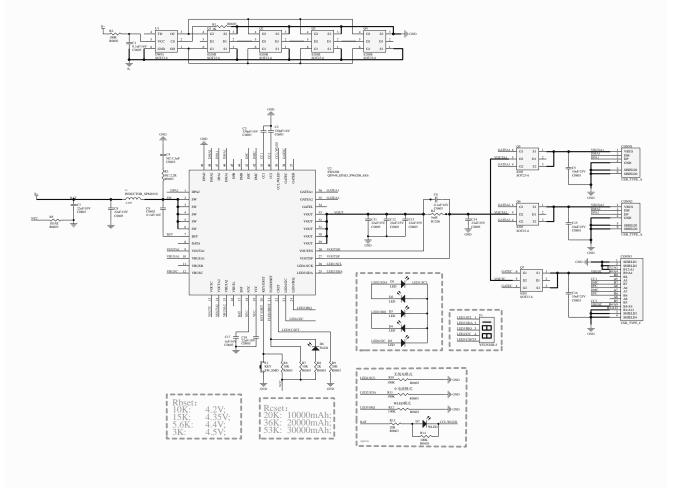
### 2.4 SW6208+A+A+B+LED/普通 188 数码管



- (1) 、VBUSL/GATEL/DATA/VBUSC/GATEC/CC1/CC2/DPC/DMC 和 CCL/WLED 悬空, 去掉 L 口 和 Type-C 口的通路管、L 口的 ID1 Pin 与 ID0 Pin 之间串联的电阻、L 口和 Type-C 口母座及输入滤波电容;
- (2) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

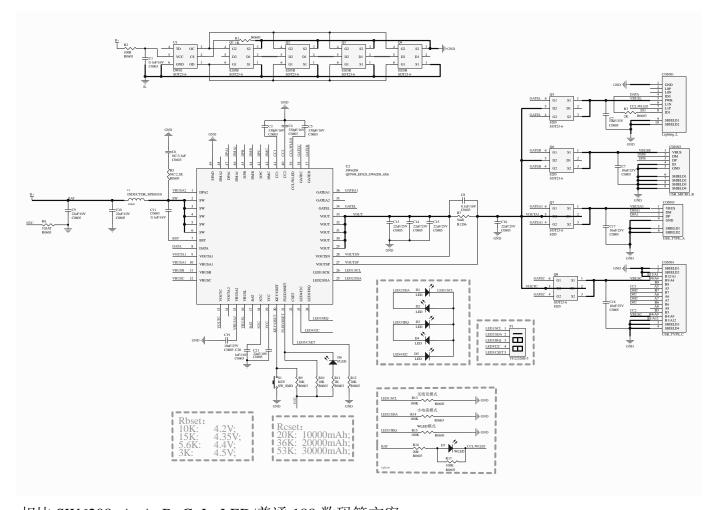
### 2.5 SW6208+A+A+C+LED/普通 188 数码管



- (1) 、VBUSB/GATEB/DPB/DMB/VBUSL/GATEL/DATA 和 CCL/WLED 悬空, 去掉 L 口和 Micro-B 口的通路管、L 口的 ID1 Pin 与 ID0 Pin 之间串联的电阻、L 口和 Micro-B 母座及输入滤波电容;
- (2) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

### 2.6 SW6208+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管



相比 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管方案,

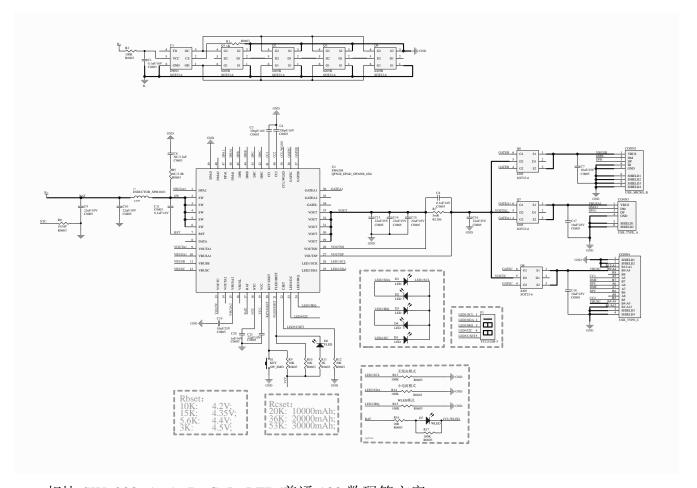
(1) 、VOUTA2/GATEA2/DMA2 悬空, 去掉 Type-A2 口母座和通路管,将 DPA2 与 VBUSA2 短接,保留 VBUSA2 的输出滤波电容;

第8页共16页

(2) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

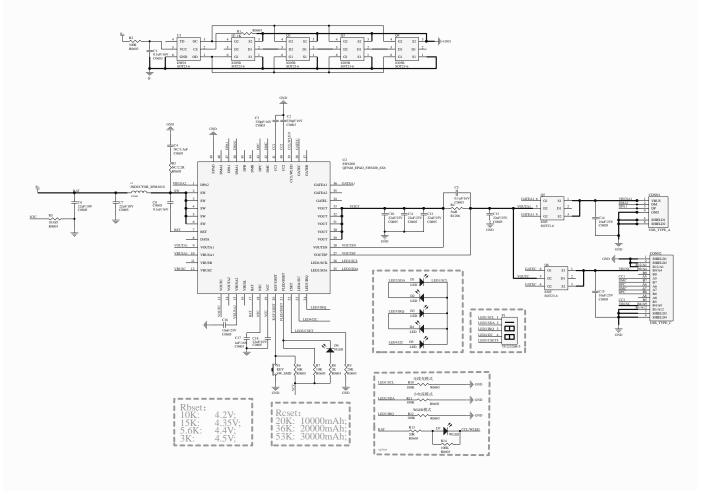
#### 2.7 SW6208+A+B+C+LED/普通 188 数码管



- (1) 、VOUTA2/GATEA2/DMA2/VBUSL/GATEL/DATA 和 CCL/WLED 悬空, 去掉 Type-A2 口和 L 口母座和通路管, 去掉 L 口输入滤波电容、L 口的 ID1 Pin 与 ID0 Pin 之间串联的电阻, 将 DPA2 与 VBUSA2 短接, 保留 VBUSA2 的输出滤波电容;
- (2) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

#### 2.8 SW6208+A+C+LED/普通 188 数码管

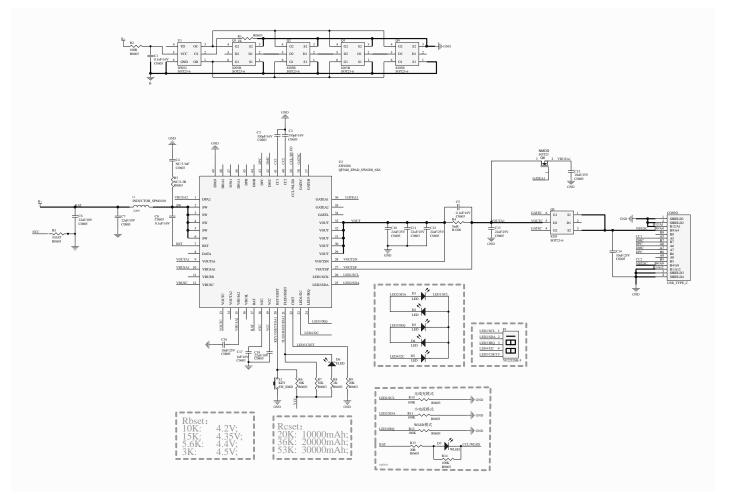


- (1)、VOUTA2/GATEA2/DMA2/VBUSB/GATEB/DPB/DMB/VBUSL/GATEL/DATA 和 CCL/WLED 悬空,去掉 Type-A2 口、Micro-B 口、L 口母座和通路管,去掉 L 口、Micro-B 口输入滤波电容, L 口的 ID1 Pin 与 ID0 Pin 之间串联的电阻,将 DPA2 与 VBUSA2 短接,保留 VBUSA2 的输出滤波电容;
  - (2)、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

www.ismartware.com

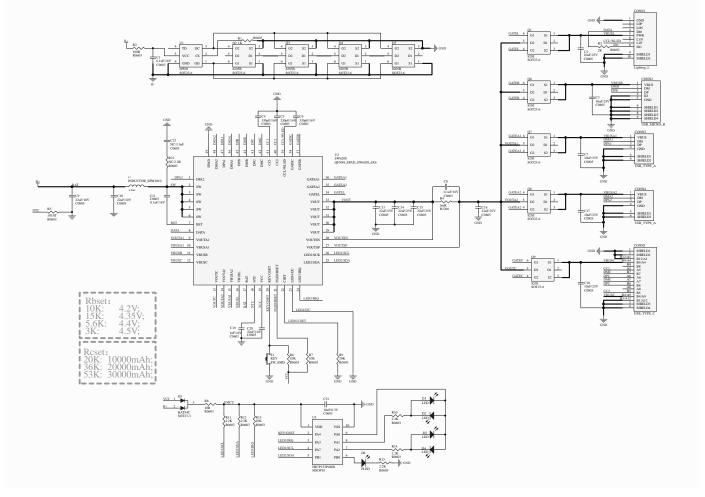
#### 2.9 SW6208+C+LED/普通 188 数码管



- (1)、VOUTA2/GATEA2/DMA2/DPA1/DMA1/VBUSB/GATEB/DPB/DMB/VBUSL/ GATEL/DATA 和 CCL/WLED 悬空,去掉 Type-A2 口、Micro-B 口、L 口母座和通路管,去掉 Lightning 口、Micro-B 口输入滤波电容、L 口的 ID1 Pin 与 ID0 Pin 之间串联的电阻、将 DPA2 与 VBUSA2 短接、保留 VBUSA1、VBUSA2 的输出滤波电容;
  - (2)、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。

ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

#### 2.10 SW6208+A+A+B+C+L+MCU+LED

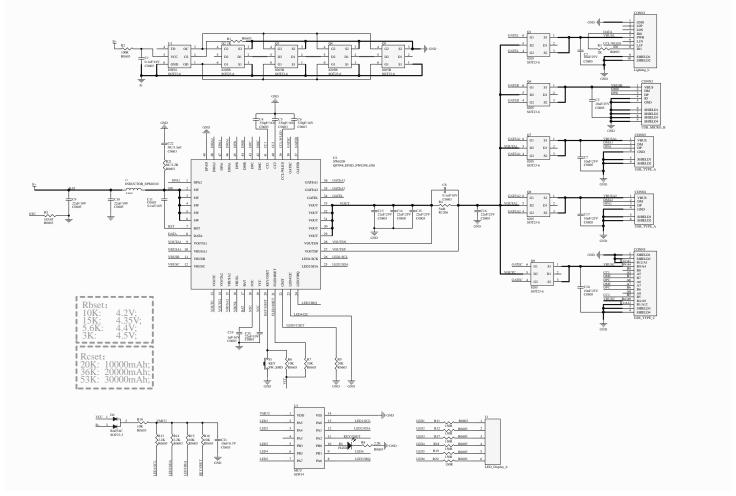


- (1)、LED4/I2C 接地,表示工作在 I2C 模式; LED1/SCK、LED2/SDA、LED3/IRQ 分别接 MCU 的 SCL、SDA、IRQ, 并上拉到 VCC 或 MCU 的输入电源;
  - (2)、KEY/GSET接MCU的一个IOPin上;
  - (3)、快充指示灯由 MCU 驱动点亮;
- (4)、MCU 的输入电源采用 VCC 供电及 B+中的较高电压者供电,输入电容 10uF,减小电源波动对 MCU 工作的影响。VMCU 供电尽量不要超过 20mA,避免芯片效率降低及发热。VCC 电压会在 BAT 及 5V 之间变动,如果 MCU 需要稳定工作电压,可使用 LDO;
- (5)、LED1/SCK、LED2/SDA、LED3/IRQ不再用于无线充模式、小电流模式及照明驱动功能设置,这三种模式可通过 MCU 写寄存器进行设置;
  - (6) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+LED/普通 188 数码管参考设计。



ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

#### 2.11 SW6208+A+A+B+C+L+MCU+普通 188 数码管



相比 SW6208+A+A+B+C+L+MCU+LED 方案,

- (1)、LED 显示换成数码管显示,数码管限流电阻根据要求选定;由于 Pin 需求增加,MCU 需要换成 14Pin 或 16Pin;
  - (2) 、其他参照 SW6208+A+A+B+C+L+MCU+LED 参考设计。



ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

#### 3. 元器件选型

#### 3.1 电阻选型

VOUT 端电流采样电阻的选型要求为: 阻值 5mohm 合金电阻, 封装 1206, 精度 1%, 温度系数 <100PPM; 其他电阻, 除标明要求 1%外, 精度 5%即可, 封装根据功率要求及 PCB layout 方便决定。

#### 3.2 电容选型

- (1)、电池端滤波电容,陶瓷电容,容值 22uF,0805 封装,耐压 10V 及以上;
- (2)、VOUT 端滤波电容,陶瓷电容,容值 22uF,0805 或 1206 封装,耐压 25V 及以上;
- (3)、USB 母座端滤波电容, 陶瓷电容, 容值 10uF 或 22uF, 0805 封装, 耐压 16V 及以上;
- (4)、其他低容值电容采用封装0603或0402,耐压根据标注的陶瓷电容。

#### 3.3 电感选型

电感选型建议: 感值 2.2uH, 电感饱和电流 10A 以上, DCR 小于  $8m\Omega$ , 推荐 SPM10102R2MESN;

#### 3.4 通路管选型

通路管选用 NMOS, NMOS 的选型要求为: VDS 耐压 20V, VGS 耐压 12V, Rdson<20m Ω @VGS=4.5V, 可采用两颗并联降低内阻, 如一颗 8205 内的 2 颗 NMOS 并联使用。

下表为推荐的几种 NMOS 型号:

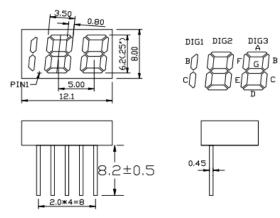
型号	Rds_on/m $\Omega$ (Vgs=4.5V)	Vds_max/V	Vgs_max/V	厂家
8205	25	20	12	
AO3420	18	20	12	ALPHA&OMEGA



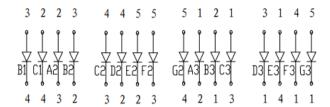
ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

### 4. 附录

#### 4.1 型号 YF2252SB-5 普通 188 数码管



#### 4. 电路图 (Circuit Diagram):





ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

### 4.2 型号 KHP3025185 快充 188 数码管

